

(12) 특허협력조약에 의하여 공개된 국제출원

(19) 세계지식재산권기구
국제사무국



(10) 국제공개번호
WO 2020/138709 A1

(43) 국제공개일
2020년 7월 2일 (02.07.2020)

- (51) 국제특허분류: **G01N 25/14** (2006.01) **G01N 9/00** (2006.01) 공개: — 국제조사보고서와 함께 (조약 제21조(3))
- (21) 국제출원번호: PCT/KR2019/015261
- (22) 국제출원일: 2019년 11월 11일 (11.11.2019)
- (25) 출원언어: 한국어
- (26) 공개언어: 한국어
- (30) 우선권정보: 10-2018-0168622 2018년 12월 24일 (24.12.2018) KR
- (71) 출원인: 주식회사 세미부스터 (SEMIBOOSTER CO., LTD.) [KR/KR]; 40046 경상북도 성주군 선남면 유서리길 174-12, Gyeongsangbuk-do (KR).
- (72) 발명자: 이승훈 (LEE, Seung Hun); 42918 대구시 달성군 다사읍 죽곡1길 42, 103동 1805호, Daegu (KR). 이송현 (LEE, Seung Hyun); 42747 대구시 달서구 학산남로 90, 111동 1902호, Daegu (KR).
- (74) 대리인: 특허법인(유한) 해담 (HAEDAM IP GROUP); 06132 서울시 강남구 논현로 503, 송촌빌딩 1601호, Seoul (KR).
- (81) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 국내 권리의 보호를 위하여): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 역내 권리의 보호를 위하여): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 유라시아 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 유럽 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).



WO 2020/138709 A1

(54) Title: METHOD FOR ANALYZING SILICON CONCENTRATION IN PHOSPHORIC ACID SOLUTION

(54) 발명의 명칭: 인산용액 중의 실리콘 농도 분석방법

(57) Abstract: The present invention relates to a method for analyzing the concentration of silicon by using the solubility of silicon in a phosphoric acid solution to analyze the concentration of silicon generated in the process of etching silicon nitride. The method for analyzing silicon concentration of the present invention has an effect of providing a method capable of analyzing only the concentration of silicon generated in the phosphoric acid process of etching silicon nitride, and optionally capable of analyzing the concentration of a silicon compound added to increase selectivity.

(57) 요약서: 본원 발명은 실리콘나이트라이드를 식각하는 공정에서 발생한 실리콘의 농도를 분석하기 위해 인산용액에서 실리콘의 용해도를 이용하여 실리콘의 농도를 분석하는 방법에 관한 것이다. 본원 발명의 실리콘 농도 분석방법은 실리콘나이트라이드를 식각하는 인산공정에서 생성되는 실리콘의 농도만을 분석할 수 있으며, 선택적으로는 선택비를 증가시키기 위해 첨가한 실리콘화합물의 농도도 분석할 수 있는 방법을 제공하는 효과가 있다.